

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成17年10月13日(2005.10.13)

【公開番号】特開2000-82671(P2000-82671A)

【公開日】平成12年3月21日(2000.3.21)

【出願番号】特願平10-248709

【国際特許分類第7版】

H 0 1 L 21/205

H 0 1 L 21/20

H 0 1 S 3/00

H 0 1 S 3/02

H 0 1 S 5/30

【F I】

H 0 1 L 21/205

H 0 1 L 21/20

H 0 1 S 3/00

H 0 1 S 3/18

H 0 1 S 3/02

【手続補正書】

【提出日】平成17年6月9日(2005.6.9)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項7

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項7】

上記GaN層の格子定数aを、 $0.3180\text{ nm} \sim 0.3183\text{ nm}$ の範囲内に形成することを特徴とする請求項6に記載の窒化物系III-V族化合物半導体装置の製造方法。